2-3 磁界中の電子の運動

2-3-1 ローレンツカ(Lorentz force)

電場E、磁場B中を速度vで運動する荷電粒子eは

$$F = eE + ev \times B$$

の力 $(\mu - \nu \nu)$ カF) を受ける。キャリアとして電子 (電荷 -e) を考えると、図 1 の座標系において電子に働く力は

$$\mathbf{F}_e = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v}_e \times \mathbf{B})$$

で表される。ここで、eE は点電荷に働く力の一般化 (静電場)。 今、E=0 では

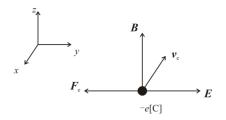


図1 磁場および電場中の電子

$$\mathbf{F}_{e} = -e(\mathbf{v}_{e} \times \mathbf{B})$$

となるので、電子に作用する力 F_e の方向はベクトル積 $-(v_e \times B)$ の方向、すなわち-y方向となる。

2-3-2 ホール効果

ホール効果(Hall effect)は、1879年にE.H. Hall (米)が金属片について発見した効果で、金属や半導体に電流を流し、電流と直交して磁界を掛けると電流、磁界と直角をなす方向に起電力が生ずる現象である。

簡単化のためキャリアとして電子のみのモデルを考える(このモデルは金属やn型半導体に適用される)。図 2に示すように、幅w、長さl、厚さdの試料にx方向に電流l、z方向に磁界Bを掛けた時に生じるy方向の試料端面の電圧 V_H を求める。

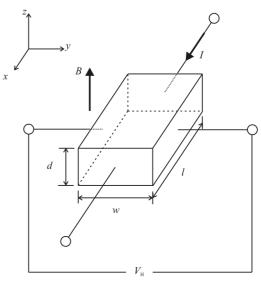
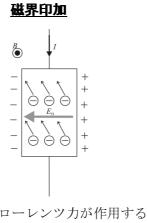
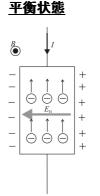


図2 ホール効果の座標系

電流 /、磁界なし 磁界を 電子は-x 方向に移動する。 このときの電流密度 J は J=-env



ローレンツ力が作用する(-y 方向)。F = evB ホール電圧 V_H が誘起され、ホール電界 E_H が生じる。



磁界による力 evB と電界による力 eE_H が釣り合った状態となる。

$$E_H = vB = -\frac{1}{en}JB = R_HJB$$

ホール電圧 V_Hは

$$V_H = wE_H = wR_H JB = wR_H \frac{I}{wd} B = \frac{R_H}{d} IB$$

となる。ホール係数 R_H[m³/C]は一般に

キャリアが電子のとき: $R_H = -\frac{\gamma}{en}$

キャリアが正孔のとき: $R_H = \frac{\gamma}{ep}$

となり、 γ は補正係数で、金属では1、半導体で $3\pi/8$ となる。

電子と正孔の両キャリアを同時に考慮する場合は、RHは次のようになる。

$$R_{H} = \gamma \frac{\mu_{p}^{2} p - \mu_{n}^{2} n}{e(\mu_{p} p + \mu_{n} n)}$$

また、ホール移動度(Hall mobility) $\mu_H = |R_H| \sigma$ より、キャリアの移動度(ドリフト移動度) μ は $\mu = \mu_H/\gamma$ となる。

ホール測定

半導体材料の材料パラメータ (キャリア密度やキャリア移動度など)を知る方法として、ホール測定が行われる。

- ・試料に電流と磁界を加えた時に発生するホール電圧 $V_{\rm H}$ を測定し、ホール係数 $R_{\rm H}$ を求める。
 - (1) ホール係数 R_H の符号よりキャリアの種類(半導体が n 形か p 形か)を判別できる。
 - (2) ホール係数 R_H がわかると $\underline{+ v \cup P \otimes g}$ (電子密度nまたは正孔密度p)が算出できる。
- ・試料の導電率 σ (または抵抗率 ρ) を測定すると、
 - (3) **キャリアの移動度***u* が算出できる。

ホール効果の応用

ホール効果を利用して、磁気量を電圧に変換する素子をホール素子という。ホール電圧が磁気量に比例することから、磁気センサや電流センサ等に用いられる。ホール素子には半導体材料として、移動度が大きい GaAs や InAs といった化合物半導体がよく使用される。